EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER PUBLICATION DATE

: 2000302544

: 31-10-00

APPLICATION DATE

: 20-04-99

APPLICATION NUMBER

: 11112839

APPLICANT: FUJI ELECTRIC CO LTD:

INVENTOR: OKAMOTO KENJI:

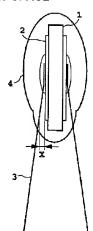
INT.CL.

: C04B 35/46 H01G 4/12

TITLE

: DIELECTRIC CERAMICS AND

DIELECTRIC CERAMICS CAPACITOR



ABSTRACT : PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a ceramic capacitor having high AC insulating withstand voltage, generating high partial discharge voltage when an Ac is supplied and suitable as a noise filter for a power converter.

> SOLUTION: The dielectric ceramics 1 is obtained by mixing and pulverizing a BaTiO3 ceramics consisting of oxides and multiple oxides of Ba, Ti, Ca, Zn, Nb and Mn as principal components, i.e., 87-90 wt.% BaTiO3, 4-6 wt.% BaZrO3, 2-3 wt.% CaTiO3, 2-3 wt.% ZnTiO3, 0.5-1.5 wt.% Nb2O5, 0-0.08 wt.% Mn3O4, 0.4-0.6 wt.% BaCO3 and 0-0.4 wt.% kaolinite, based on 100 wt.% total weight, compacting the pulverized ceramics and firing it. When the dielectric ceramics is molded using a resin 4, a lead wire 3 is kept apart from the edge of the electrode 2 by at least 0.3 mm.

COPYRIGHT: (C)2000, JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-302544 (P2000-302544A)

(43)公開日 平成12年10月31日(2000.10.31)

(51) Int.CL.7		識別記号	FI	7~71~}*(参考)
C 0 4 B	35/46		C 0 4 B 35/46	D 4G031
H01G	4/12	313	H01G 4/12	313 5E001

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 6 頁)

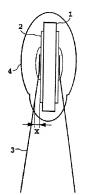
(21)出願番号	特顧平11-112839	(71) 出顧人 000005234
(22)出籍日	W 111 12 4 1200 12 (1000 4 00)	富士電機株式会社
(DD) DIRECT	平成11年4月20日(1999.4.20)	神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号
		(72)発明者 深澤 直人
		神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号
		富士電機株式会社内
		(72)発明者 岡本 健次
		神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号
		富士電機株式会社内
		(74)代理人 100077481
		弁理士 谷 養一 (外2名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 誘電体セラミックスおよび誘電体セラミックスコンデンサ

(57)【要約】

【課題】 高い交流絶縁制電圧を有し、交流印加時に発生する部分放電電圧の高い、電力変換器用ノイズフィルケンに対適な、セラミックスコンデンサを提供する。【解決手段】 主成分が、Ba、Ti、Ca、Zn、Nb、Mnの各酸化物および複合酸化物からなるBaTi 0_3 系セラミックスを興料とし、全体重量を100 wt %として、BaTi 0_3 : 2^{-2} 0 wt %、BaZ 1^{-2} 0 m v %として、BaTi 1^{-2} 0 m v %として、BaTi 1^{-2} 0 m v % BaZ 1^{-2} 0 m v % 1^{-2



【特許請求の範囲】

【請求項1】 スイッチングノイズを沪波するノイズフィルタを構成するコンデンサに用いる誘電体セラミックスであって、

その主張分が、Ba、Ti、Ca、Zn、Nb、Mnの
各酸化物および複合酸化物からなるBaTiO₃:系セラ まックスを原料とし、全体重量を100wt%として、 BaTiO₃:87~90wt%、BaZrO₅:4~6 wt%、CaTiO₅:2~3wt%、ZnTiO₅:2 ~3wt%、Nb₂O₅:0.5~1.5wt%、Mn₅ O₄:0~0.08wt%、BaCO₅:0.4~0.6 wt%、カオリナイト:0~0.4wt%という重量比 で、これらの成分が混合物幹された後、成形、規成され てなることを特徴とする場面になっまった。

【請求項2】 スイッチングノイズをデ液するノイズフィルタを構成するコンデンサであり、請求項1の誘電体セラミックスの両側部に電電が形成され、これらの電像にリード線が接続され、前記誘電体セラミックスが樹脂によりモールドされてなる誘電体セラミックスコンデンサであって、

前記リード線が、前記誘電体セラミックスの電極のエッ ジ部から少なくとも0.3mm以上離れて、固定されて いることを特徴とする誘電体セラミックスコンデンサ。 【条明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、インバータなど の電力変換器を構成する半導体スイッチ素子のスイッチ ング動作に伴って発生するスイッチングノイズを沪波す る電力変換器のノイズフィルタに用いて好適な接地用誘 電体セラミックスコンデンサに関する。

[0002]

【従来の技術】周知のように、インバータなどの電力変 機器を構成する半導体スイッチ素子のスイッチング動作 は、キャリア周波数が歌とHzから十数kHz程度とし たバルス幅変換(PWM)された駆動信号に基づいて行 われる。そして、このスイッチング動作により十数kH ェ以上の周波数成分のスイッチングノイズが、この電力 変換器から発生する。

【0003】近年、上記スイッチングノイズの周波数成 かの内の百kHz以上の成分が外部機器に与える悪影響 を抑制することを目的に、当該する電力変換器に様々の 法的規制が敷かれた。この法的規制に対応するために、 電力変換器用ノイズフィルタをこの電力変換器に設置し ている。

【0004】 従来のこの種の電力変換器用ノイズフィル タとしては、フェライト、非晶質合金、結晶合金などか らなるコアに電線を巻回してなる単体のリアクトルと、 フィルムやセラミックスチップなどからなる単体のコン デンサとを、相間、接地間に接続して構成したものがあ ッチング動作に伴って発生するスイッチングノイズを沪 波するようにしている。

【0005】特に、接地用コンデンサは高い交流の絶縁 耐電圧が必要とされるため、容量の大きなフィルムコン デンサをシリーズに繋ぎ、個々のコンデンサにかかる電 圧を低下させて用いたり、容量の小さなコンデンサを述 別に接続して回路を形成したりしており、最適なコンデ ンサがなかった。特に、接地コンデンサは、インバータ か仕費からんて3000V×15の交流絶縁耐電圧(Break Down Voltage;以下、BDV(AC)と記す)を満 たす必要があり、高誘電率でかつ厚さが導い誘電体シー トで上記のBDV(AC)特性を満たすのは困難であっ た。

【0006】また、コンデンサに交流が印加された時に 発生する部分放電電圧の高いコンデンサはなかった。 【0007】

【発明が解決しようとする課題】この発明の課題は、上 記従来の問題点を解決した、より小型簿型で、 製造コス トの低い、電力変換器用ノイズフィルタに用いて好適な セラミックスコンデンサを提供することにある。

[8000]

[0009] この請求項1の発明の目的は、電力変換器を構成する半薄体スイッチ素子のスイッチング動作に伴って発生するスイッチングイズを汚換するために備えた複数個のLとCの組み合わせを有する電力変換器用ノイズフェルタに用いたおも接地コンデンサ用高耐電圧小型コンデンサに用いて好適な誘電体セラミックスを提供することにある。

【0010】BaT10。セラミックスの比誘電率は、 キューリー温度付近(約120℃)では6000~70 00にもなる。しかし、このセラミックスをコンデンサー にそのまま用いると、このセラミックスは圧電性も有す るために、BDV(AC)特性は非常に低かった。電力 変換器用のノイズフィルタに用いられるセラミックスの 仕様としては、誘電率が3000程度、BDV(AC) は実行値で3kV以上に耐えられることが必要である。 が、一方、板厚を厚くすると、コンデンサとしての容量 が低下する。さらに、小型化のためには、なるべく板厚 は薄いことが好ましい。すなわち、BDV (AC)の電 界強度は高いことが察望される。

【0011】本発明のコンデンサ用のセラミックスは、BaTiO。を基本にして、その高い誘電率を保持しつ、Ca、Zr、Nb、Mnの酸化物および核合酸化物を添加し、なるベく小さな粒径で都密に焼成し、交流の耐電圧特性を向上させ(BDV(AC)を≧6kV/mm、誘電率を≧3000)、誘電率の温度特性を改善する。また、焼成温度の低温化によって、製造の低コスト化も図っている。

【0012】また、コンデンサ自身の端子外装間の絶縁性、難燃性を考慮するとともに、モールド樹脂のボットライフをも考慮すると、コンデンサの外被モールドが低コストで実用的である。しかし、このモールドを用いた場合、コンデンサの細部まで動体機能を充填するのが困難であった。特に、部分放電が発生しやすいAg電極エッジ部と電極面から水平に出したリード線の下には樹脂が入りこまず、部分放電電低かった。

【0013】これに対して、本発明では、セラミックスコンデンサから引き出したリード線と電極エッジ部との 四離を離すことにより、部分放電消滅電圧をミ1kV以 上にしている。この構成を限定したコンデンサが、本発明の請求項2である。すなわち、本発明の請求項2である。すなわち、本発明の請求項2の誘電派改するノイズフィルシを構成するコンデンサであり、請求項1の誘電体セラミックスの両側部に電極が形成され、これらの電極にリード線が終続され、前記誘電体セラミックスフが側距によりモールドされてなる誘電体セラミックスコンデンサであって、前記リード線が、前記誘電体セラミックスコンデンサであって、前記リード線が、前記端電体セラミックスの電極のエッジ部から少なくとも0.3mm以上離れて、固定されていることを特徴とする。【0014】

【実施例】以下、本発明の実施例を図面を参照して説明する。参照図面の図1には、本発明にかかるセラミックスコンデンサうちからなる電力変換器用ノイズフィルタ全体の回路図を示す。本発明のコンテンサうは、アースEに接続される接触用コンデンサウをある。図中の符号6はリアクトルである。また、図2および図3は、発明のセラミックスコンデンサの上面図および断面図であり、リード線3の取り出し方法を示している。図2および図3において、符号1は誘電体セラミックス、2は4名電電極、3はリード線、4はモールド樹脂である。

【0015】(実施例1) 純度99%以上の複合酸化物 BaTiO₃, BaZrO₃, CaTiO₃, ZnTiO₃ と、酸化物Nb₂O₅, Mn₈O₄, BaCO₃と、焼焼助 剤としてのSiO₂およびAl₂O₃と、を主成がよっる カナリナイト(METSPL / METSPL / の原料分として、準備した。

【0016】これらを表1に示す配合比で配合混合し、ボールミルによる湿式粉砕により、48時間にわたって 粉砕混合を行い、1µm以下に微粉砕した。そして、ボ リビニルブチラールなどのバイングを添加し、スプレー ドライヤーにより流動性の高い造粒粉を作った。

【0017】この造粒粉を一定量とり、金型に入れて成 形圧1~2 to n/cn*でプレス成形した。本実施例 では、640mmの金型に入れ、厚ち1mmにアレス成 形した。そして、1150℃~1350℃の範囲で焼成 し、約632mm、厚さ0.8mmの誘電体セラミック スを作った。

た。これらの測定結果を、表2に示す。 【0021】なお、添加したBaZrOgは、セラミックスの加熱製造時のキューリー温度を低温側に下げるためのシフターである。

【0022】BaTiのセラミックスの比誘電率は、 キューリー温度付近(約120℃)では6000~70 00にもなる。このセラミックスを、そのままコンデン サーに用いると、温度特性が悪いのと圧電性が大きいこ とのために、BDV(AC)特性は非常に低い。

【0023】本発明においては、このBDV (AC)特性としては、6kV/mm以上を目的としている。この値では、実際には0.5mmの厚さのセラミックスで、3kVACに耐えることが可能であり、薄いため、小さな電極形状で大きな静電容量を確保することができる。また、前電率は3000以上、温度特性はXB規格を目指している。

【0024】そのため、本発明では、BaZrO。をキューリー温度を低温側に動かすshiftorとして添加し、温度特性を平坦化するためにdepressorとしてCaTiO。を添加している。また、焼結温度を下げることを主目的にZnTiO。カオリナイトを主成分とする蛙目粘土を添加している。

【0025】また、絶縁抵抗を向上させるために、主に 還元防止目的に、Nb2OsとMn3Osを添加している。 これらの添加物と過剰なBaCOsは、低温焼成、粒界 絶縁の向上に寄与している。表2に示した誘電体セラミ であり、表1以外にも種々の配合比を検討したが、表1 中の○印の重量配合比が、フィルタ用コンデンサに用い

【0026】 【表1】

るための特性を満足していた。

重量配合比

			複合	酸化	物	Ē	党 化	物	焼結助剤	総計
		BaTiO ₃	BaZrO ₃	CaTiO ₃	ZnTiO ₃	Nb ₂ 0 ₅	Mo ₃ O ₄	Baco ₃	蛙目粘土	(%)
	1	93. 197	0	2	2.702	1.201	0.06	0.48	0.36	100
	2	91. 197	2	2	2.702	1.201	0.06	0.48	0.36	100
0	3	89.197	4	2	2.702	1.201	0.06	0.48	0.36	100
0	4	87. 197	6	2	2.702	1.201	0.06	0.48	0.36	100
	5	89. 997	5. 2	0	2.702	1.201	0.06	0.48	0.36	100
	6	88. 997	5.2	1	2.702	1.201	0.06	0.48	0.36	100
0	7	87.997	5.2	2	2.702	1.201	0.06	0.48	0.36	100
0	8	86. 997	5.2	3	2.702	1.201	0.06	0.48	0.36	100
_	9	90.369	5.2	2. 33	0	1.201	0.06	0.48	0.36	100
	10	89. 369	5.2	2. 33	1	1.201	0.06	0.48	0.36	100
0	11	88.369	5.2	2.33	2	1.201	0.06	0.48	0.36	100
0	12	87. 369	5.2	2.33	3	1.201	0.06	0.48	0.36	100
	13	86. 369	5.2	2.33	4	1.201	0.06	0.48	0.36	100
	14	87.667	5. 2	2.33	2.702	0	0.06	1. 681	0.35	100
	15	87.667	5.2	2.33	2.702	0.5	0.06	1.181	0.36	100
0	16	87.667	5.2	2.33	2.702	ı	0.06	0.681	0.36	100
О	17	87.667	5.2	2.33	2.702	1.5	0.06	0.181	0.36	100
0	18	87.667	5.2	2.33	2.702	1.201	0	0.54	0.36	100
С	19	87.667	5.2	2. 33	2.702	1.201	0.06	0.48	0.36	100
C	20	87.667	5.2	2.33	2.702	1.201	0.1	0.44	0.36	100

Г		焼成温度	BDA (AC)	粒 径	誘 電 率	誘電率の温度変化		
		(℃)	(kV/mm)	(µ m)	25℃, lkHz	-55℃	85℃	
	1	1350℃	≥ 2	0.5 ~1	2800	-20	50	
	2	1310℃	> 3	0.ā ~1	2900	-20	40	
0	3	1300℃	≥6	0.5 ∼1	3000	-10	10	
0	4	1300℃	≥6	0.5 ~ 1	3200	-10	10	
Г	5	1290℃	≥4	0.5 ~ 1	2800	-30	30	
	6	1280℃	≥4	1~1.5	2900	-20	20	
0	7	1250°C	≥ 6	0.5 ~ 1	3000	-10	10	
0	8	1250°C	≥ 6	1~2	3000	-10	-10	
r	9	1340℃	≧ 4	0.5 ~ 1	3500	-10	-10	
	10	1300℃	≥4	0.5 ~ 1	3400	-10	10	
0	11	1250℃	≥ 6	0.5 ~ 1	3300	-10	-10	
0	12	1240℃	≥ 6	1~2	3500	-10	-10	
	13	1230℃	≧ 5	2~3	3300	-20	-20	
	14	1250℃	≥ 3	1~2	4000	-10	-20	
	15	1 240℃	≥ 5	1~2	3900	-10	-20	
0	16	1230℃	≥ 7	0.5 ~ 1	3700	-10	-10	
0	17	1230℃	≧ 7	0.5 ~ 1	3600	-10	-10	
0	81	1230℃	> 7	0.5~1	3500	-10	-10	
0	19	1210℃	≥ 9	0.5 ~1	3200	-10	-10	
0	20	1200℃	≥ 8	0.5 ~1	3000	-10	-10	
					1	- 1		

【0028】(実施例2) 実施例2は、上記実施例1の 誘電体セラミックス1にAs電極2を印刷し、リード線 Sを付ける時、図2および図3に示すように、誘電体セ ラミックス1の阿面のAs電極2の未端部分から0.3 mm以上の距離Xだけリード線3を離すことを、特徴と している。

[0029] 一般に、接地用コンデンサ5自身の端子外 装間の絶縁性、難燃性を考慮し、かつモールド樹脂4の ボットライフを考慮すると、フィラー入りのエボキシ粉 体モールドが低コストで実用的である。しかし、このモ ールド材を用いた場合、従来は、細部まで粉体樹脂を充 填するのが困難であった。従来のコンデンサのモールド 様では、特に、部分放電が発生しやすいAs電極2の末 場部分(エッジ部)と電極面から水平に出したリード線 3の下には樹脂が入りこまず、そこに小さな空隙がで き、また、リード線の誘電体セラミックスに対する沿面 距離も短くなるため、部分放電開始と消波電圧が低かっ た。 リード線3を電極2のエッジ部より離してモールドする ことにより、部分放電電圧を低減することが可能になっ

[0031] この実施例2では、日本ベルノックス製 P CE282GREY 4Aをモールド観指とし使い、次のような特体 流動槽に数回ディッピングする工程により、モールドした。

【0032】モールド工程、第1子熱(140℃×1. 5 min) 一樹脂にディッピング一第2子熱(140℃ ×1.5 min) →樹脂にディッピング一第3子熱(1 40℃×1.5 min) →樹脂にディッピングーアフタ ーキュアー(140℃×1.5 min) →キュアー(1 50℃×1 hr).

【0033】このモールド作成の際に、リード線3と電極2のエッジ部までの距離Xを変えて試験した。その結果、0.3mm以上の距離をもだば、リード線3の直下のAg電極2のエッジ部に空隙が生じずに、モールドが可能になり、部分放電消滅電圧が31kVACにするこ

[0034]

【発明の効果】この売明によれば、濡い誘電体セラミックスでも高いBDV(AC)特性を得ることが可能であり、セラミックスコンデンサの薄型小型化につながる。また、薄い誘電体セラミックスを使うことにより、コンデンサとして大きな静電容素を得ることが可能になる。【0035】また、リード級を電極のエッジ部より離して固定することにより、電極のエッジ部にモールドの空隙ができず、1kVAC以上の部分放電電圧を得ることが可能になる。

【図面の簡単な説明】

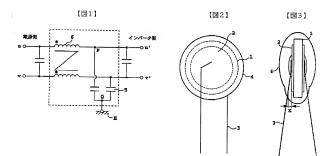
【図1】本発明により実現される電力変換用ノイズフィルタの一例の回路図である。

【図2】本発明に係る誘電体セラミックスコンデンサの 上面図である。

【図3】本発明に係る誘電体セラミックスコンデンサの 断面図である。

【符号の説明】

- 1 誘電体セラミックス
- 2 Ag電極
- 3 リード線
- 4 モールド樹脂
- 5 接地用コンデンサ (セラミックスコンデンサ)
- 6 リアクトル
- E アース



フロントページの続き

F ターム(参考) 46031 AA04 AA06 AA11 AA12 AA14 AA19 AA26 AA40 BA09 5E001 AB01 A009 AB00 AE02 AE03 AE04 AF00 AF03 A601 AH01 AB05 AB09 AJ01 AJ02 AJ03